

トランジスタ

2SC2076

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

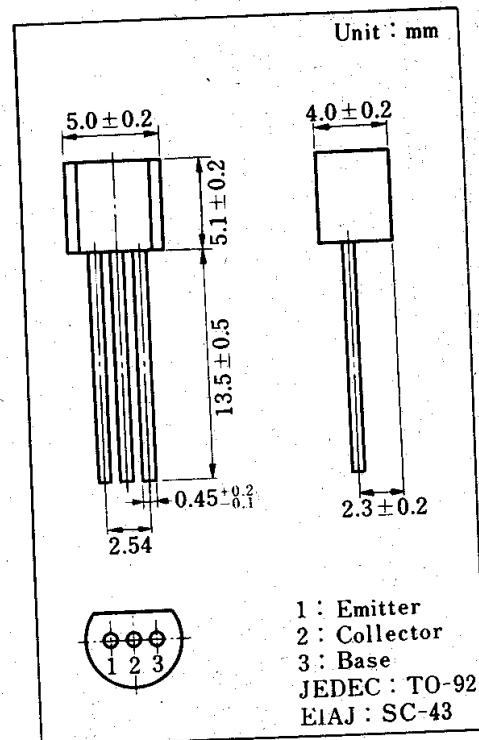
高周波増幅用 / RF Amplifier

■ 特徴 / Features

- AM/FM ラジオの RF 増幅, 発振, 混合, IF に最適です。
Suitable for RF amp., OSC, mix. and IF amp. in FM/AM radios.
- サージ破壊強度が大きい。 / Large with standing capability against surge voltage.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

| Item | Symbol | Value | Unit |
|-------------|------------------|------------|------|
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CBO} | 35 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO} | 30 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V _{EBO} | 4 | V |
| コレクタ電流 | I _C | 20 | mA |
| コレクタ損失 | P _C | 400 | mW |
| 接合部温度 | T _J | 150 | °C |
| 保存温度 | T _{stg} | -55 ~ +150 | °C |



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

| Item | Symbol | Condition | min. | typ. | max. | Unit |
|---------------|----------------------|---|------|------|------|------|
| コレクタシャ断電流 | I _{CBO} | V _{CB} = 20 V, I _E = 0 | | | 1 | μA |
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CBO} | I _C = 10 μA, I _E = 0 | 35 | | | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO} | I _C = 2 mA, I _B = 0 | 30 | | | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V _{EBO} | I _E = 10 μA, I _C = 0 | 4 | | | V |
| 直流電流増幅率 | h _{FE} * | V _{CE} = 10 V, I _C = 1 mA | 80 | | 360 | |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | V _{CE(sat)} | I _C = 10 mA, I _B = 1 mA | | | 0.4 | V |
| トランジション周波数 | f _T | V _{CB} = 10 V, I _E = -1 mA | 80 | | 200 | MHz |
| コレクタ出力容量 | C _{ob} | V _{CB} = 10 V, I _E = 0, f = 1 MHz | | | 3.5 | pF |
| 雑音指数 | NF | V _{CB} = 10 V, I _E = -1 mA, f = 100 MHz | | | 5 | dB |

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

| Class | B | C | D |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| h _{FE} | 80 ~ 160 | 120 ~ 240 | 180 ~ 360 |